

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-216605  
(43)Date of publication of application : 04.08.2000

(51)Int.CI.

H01P 5/107  
H05K 1/02

(21)Application number : 11-013004

(71)Applicant : KYOCERA CORP

(22)Date of filing : 21.01.1999

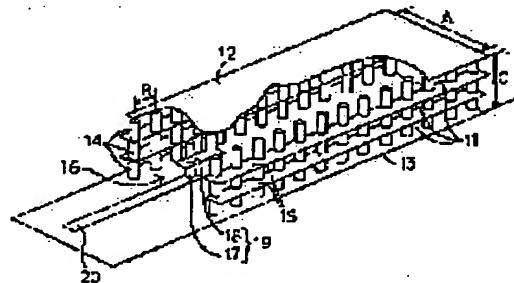
(72)Inventor: KIYOHARA TOSHIKUMI  
UCHIMURA HIROSHI

## (54) CONNECTION STRUCTURE BETWEEN DIELECTRIC WAVEGUIDE LINE AND HIGH FREQUENCY LINE CONDUCTOR

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a connection structure between a dielectric waveguide line and a high frequency line conductor that can connect the laminated dielectric waveguide line with the high frequency line conductor such as a microstrip line, a strip line or a high frequency line with an excellent characteristic even when a characteristic impedance of the dielectric waveguide line differs from that of the high frequency line conductor.

**SOLUTION:** The connection structure is used to connect a high frequency line conductor 20 with a dielectric waveguide line 16 by inserting an end of the high frequency line conductor 20 to an opening end of the dielectric waveguide line 16 consisting of a couple of main conductor layers 12, 13 having a dielectric board 11 inbetween and two rows of through-conductor groups 14 for sidewall that are formed between the main conductor layers 12, 13 at a prescribed interval with a prescribed width and of a sub conductor layer 15 and by electrically connecting the end of the high frequency line conductor 20 and one (12) of the main conductor layers 12, 13 with a connection use line conductor 18 and a connection use through-conductor 17 in a way of forming a step. Even when the characteristic impedance of the conductor 20 differs from that of the line 16, the connection structure connects the both with an excellent characteristic and since the thickness of the connection structure is thin, the connection structure can be miniaturized.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 26.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3517143

[Date of registration]

30.01.2004

[Number of appeal against examiner's decision  
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

特開 2000-216605

(P 2000-216605 A)

(43) 公開日 平成12年8月4日 (2000.8.4)

(51) Int. C1.<sup>7</sup>  
 H 01 P 5/107  
 H 05 K 1/02

識別記号

F I  
 H 01 P 5/107  
 H 05 K 1/02

テマコード (参考)  
 E 5E338  
 G  
 P

審査請求 未請求 請求項の数 1

O L

(全 7 頁)

(21) 出願番号

特願平11-13004

(22) 出願日

平成11年1月21日 (1999. 1. 21)

(71) 出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

(72) 発明者 清原 敏史

京都府相楽郡精華町光台3丁目5番地 京セラ株式会社中央研究所内

(72) 発明者 内村 弘志

京都府相楽郡精華町光台3丁目5番地 京セラ株式会社中央研究所内

F ターム (参考) 5E338 AA03 BB02 BB16 BB25 CC02

CC05 CD02 CD11 CD32 EE13

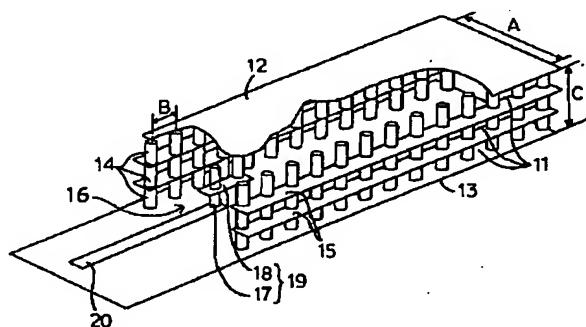
EE22

(54) 【発明の名称】誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造

## (57) 【要約】

【課題】 誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続をコンパクトな構造でもって良好な特性で行なうこと が困難であった。

【解決手段】 誘電体基板11を挟持する一対の主導体層 12・13と、所定の繰り返し間隔で、かつ所定の幅で主導体層12・13間に形成された2列の側壁用貫通導体群14と、副導体層15とを具備して成る誘電体導波管線路16の開口端に、高周波用線路導体20の端部を挿入するとともに、その端部と一方の主導体層12とを、接続用線路導体18と接続用貫通導体17とにより階段状を成すように電気的に接続した誘電体導波管線路16と高周波用線路導体20との接続構造である。両者の特性インピーダンスが異なるものであっても良好な特性で接続することができ、接続部の厚みが薄いので小型化を図ることもできる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 誘電体基板を上下から挟持する一対の主導体層と、高周波信号の伝送方向に信号波長の2分の1未満の繰り返し間隔で、かつ前記伝送方向と直交する方向に所定の幅で前記主導体層間を電気的に接続して形成された2列の側壁用貫通導体群と、前記主導体層間に主導体層と平行に形成され、前記側壁用貫通導体群と電気的に接続された副導体層とを具備して成り、前記主導体層、側壁用貫通導体群および副導体層に囲まれた領域によって高周波信号を伝送する誘電体導波管線路の開口端に、前記高周波信号を伝送する高周波用線路導体の端部を挿入するとともに、該高周波用線路導体の端部と前記主導体層の一方とを、前記高周波用線路導体と同じ伝送方向で平行に配設された接続用線路導体と、該接続用線路導体の端部に直交して配設された接続用貫通導体により階段状を成すように電気的に接続したことを特徴とする誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、マイクロ波帯やミリ波帯等の高周波信号を伝送する伝送線路である誘電体導波管線路と、マイクロストリップ線路等の高周波用線路導体とを低損失で接続できる、誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 近年、マイクロ波帯やミリ波帯等の高周波信号を用いた移動体通信および車間レーダ等の研究が盛んに進められている。これらの高周波回路において高周波信号を伝送するための高周波用伝送線路としては、従来より、同軸線路や導波管・誘電体導波管線路・マイクロストリップ線路やストリップ線路等の高周波用線路導体などが知られている。

【0003】 最近では、高周波回路を構成する配線回路内には種類の異なる高周波線路が複数配置されるために、これら高周波線路相互間の接続技術が重要となっており、その接続構造について様々な構造が提案されている。

【0004】 例えば、導波管または誘電体導波管と同軸線路との接続構造では、同軸線路の信号線を導波管内に挿入して高周波的に結合することによって接続される。

【0005】 また、導波管とマイクロストリップ線路との接続構造では、導波管とマイクロストリップ線路とを直交させて接続する場合には、マイクロストリップ線路が形成された誘電体基板を導波管内に挿入する構造が用いられる。また、導波管とマイクロストリップ線路とを平行な方向で接続する場合には、マイクロストリップ線路の線路導体を、接続する端部へ向かって曲線状に狭くしたいわゆるリッジ導波管の内部に挿入する構造が知られている。

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】 最近に至り、高周波線路を高周波回路が構成される基板上または基板内に形成すると小型化の点で有利となることから、多層構造の配線基板内に誘電体導波管線路を積層技術によって形成することが望まれるようになっている。例えば、特開平6-53711号においては、誘電体基板を一対の主導体層で挟み、さらに導体層間を接続する2列に配設されたピアホール群によって側壁を形成した導波管線路が提案されている。この導波管線路は、誘電体材料の四方を一対の主導体層とピアホール群による擬似的な導体壁で囲むことによって導体壁内の領域を信号伝送用の線路としたものである。

【0007】 このような多層配線基板の内部に配設される積層型の誘電体導波管線路を、主にマイクロ波およびミリ波用のセラミック多層配線基板あるいは高周波用半導体パッケージの伝送線路として用いる上では、他の高周波回路との接続が必要になる。

## 【0008】 これに対し、積層型の誘電体導波管線路と

20 マイクロストリップ線路との接続構造としては、図4に斜視図で概略構成を示すような、誘電体導波管線路の主導体層に設けたスロット孔による電磁的結合を用いた接続構造が提案されている。

【0009】 図4によれば、誘電体基板1を一対の主導体層2・3で挟み、さらに主導体層2・3間を接続する2列に配設されたピアホール群等の貫通導体群によって形成された側壁4とで構成される前述の積層型の誘電体導波管線路5に対し、その一方の主導体層2に電磁結合用のスロット孔6を形成し、これによって、多層配線基板7等の上に形成されたマイクロストリップ線路等の高周波線路の線路導体8と誘電体導波管線路5とを電磁的に結合して接続するものである。

【0010】 この接続構造によれば、主導体層2の一部にスロット孔6を形成することにより容易に他の高周波用線路導体と電磁結合することができる。しかも、かかる接続構造を有する高周波用線路導体8を形成した多層配線基板7ならびに誘電体導波管線路5は、いずれも従来のセラミック積層技術を応用して容易に作製することができる。

40 【0011】 しかしながら、このような積層型の誘電体導波管線路5と高周波用線路導体8との接続構造では、誘電体導波管線路5の上部に高周波用線路導体8が形成された多層配線基板7を積層しているため、接続部全体の厚みが増すこととなってしまい、接続構造全体を小型化することが困難であるという問題点があった。

【0012】 しかも、誘電体導波管線路5と、スロット孔6を介して誘電体導波管線路5に接続される高周波用線路導体8との特性インピーダンスは一般には一致しないため、接続部において特性インピーダンスの不一致による高周波信号の反射が発生し、同時に透過特性も劣化

することとなるという問題点があった。

【0013】本発明は上記従来技術の問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的は、積層型の誘電体導波管線路と、他のマイクロストリップ線路やストリップ線路・高周波線路等の高周波用線路導体と、両者の特性インピーダンスが異なるものであっても良好な特性で接続することができる誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造を提供することにある。

#### 【0014】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の問題点に対して検討を重ねた結果、誘電体導波管線路と高周波用線路導体とを接続する構造において、高周波用線路導体を誘電体導波管線路の端部に挿入し、その挿入部から接続用貫通導体と接続用線路導体とによって階段状を成すようにして高周波用線路導体の端部を誘電体導波管線路の主導体層に電気的に接続することにより、接続部の厚みが薄い構造で、しかも優れた透過特性が得られるこを見出した。

【0015】本発明の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造は、誘電体基板を上下から挟持する一対の主導体層と、高周波信号の伝送方向に信号波長の2分の1未満の繰り返し間隔で、かつ前記伝送方向と直交する方向に所定の幅で前記主導体層間を電気的に接続して形成された2列の側壁用貫通導体群と、前記主導体層間に主導体層と平行に形成され、前記側壁用貫通導体群と電気的に接続された副導体層とを具備して成り、前記主導体層、側壁用貫通導体群および副導体層に囲まれた領域によって高周波信号を伝送する誘電体導波管線路の開口端に、前記高周波信号を伝送する高周波用線路導体の端部を挿入するとともに、この高周波用線路導体の端部と前記主導体層の一方とを、前記高周波用線路導体と同じ伝送方向で平行に配設された接続用線路導体と、この接続用線路導体の端部に直交して配設された接続用貫通導体とにより階段状を成すように電気的に接続したことを見出した。

#### 【0016】

【発明の実施の形態】以下、本発明の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造について図面を参照しながら説明する。

【0017】図1は、本発明の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造の実施の形態の一例を示す部分破断斜視図である。

【0018】図1において、11は誘電体基板、12および13は誘電体基板11を上下から挟持する一対の主導体層、14は信号伝送方向に信号波長の2分の1未満の繰り返し間隔で、かつ信号伝送方向と直交する方向に所定の幅で一対の主導体層12・13間を電気的に接続するようにして形成された2列の側壁用貫通導体群である。また、15は側壁用貫通導体群14の各列を形成する貫通導体同士を電気的に接続する、主導体層12・13と平行に形成された副

導体層である。これら主導体層12・13と側壁用貫通導体群14および副導体層15に囲まれた領域によって、高周波信号を伝送する誘電体導波管線路16を構成する。

【0019】一方、20はマイクロストリップ線路やストリップ線路・高周波線路等の高周波用線路導体であり、図示しない誘電体基板上や多層配線基板内に形成されて誘電体導波管線路16と接続される。その誘電体基板や多層配線基板等は、その一部を誘電体導波管線路16の誘電体基板11の一部と共有させてもよい。

10 【0020】そして、17は接続用貫通導体、18は接続用線路導体であり、接続用線路導体18は高周波用線路導体20と同じ伝送方向で平行に配設され、接続用貫通導体17は接続用線路導体18の端部に直交して配設されており、これら接続用貫通導体17と接続用線路導体18とによって階段状を成すようにして、誘電体導波管線路16の開口端に挿入した高周波用線路導体20の端部と誘電体導波管線路16の一方の主導体層12とを電気的に接続している。

【0021】また、この接続部分の接続用貫通導体17と接続用線路導体18とで階段状の変換器19を構成している。これにより、接続部の誘電体導波管線路16において上下の主導体層12・13間の間隔を狭くしたいわゆるリッジ導波管を階段状に構成することとなり、誘電体導波管線路16と高周波用線路導体20との特性インピーダンスが異なる場合に、変換器19が両者の特性インピーダンス整合を行なうインピーダンス変換器として機能するため、接続部における高周波信号の反射損失を低減し、良好な透過特性の接続構造となる。

【0022】すなわち、高周波用線路導体20の端部は誘電体導波管線路16の開口端からその内部に挿入されており、挿入された高周波用線路導体20の端部は、接続用貫通導体17および接続用線路導体18によって構成された階段状の変換器19とともにリッジ導波管として働き、高周波信号の反射を低減させる作用をなす。このような変換器19を用いて特性インピーダンスの異なる誘電体導波管線路16と高周波用線路導体20とを低反射の状態で接続させるための特性インピーダンス調整は、変換器19を構成する誘電体基板の厚みや、接続用貫通導体17および接続用線路導体18の長さ等で調整可能である。

【0023】図1の例では、誘電体基板11を3層構造のものとして誘電体導波管線路16を構成し、接続用線路導体18は1層の線路導体で形成されているが、誘電体基板11をより多層構成とすることにより、変換部19の段数を2段・3段・4段・5段…と増すことも可能である。このように変換部19の段数を増すと、より効果的にインピーダンスのマッチングをとることができる。

【0024】また、接続用貫通導体17は、その間隔を信号波長の2分の1より小さくしていくと電磁波の漏れはなくなるため、接続用貫通導体17同士の間隔は信号波長の2分の1未満であることが望ましい。接続用貫通導体17は図1の例では1列に配設したが、複数列であっても

良い。また、いわゆる千鳥状に配置しても良い。

【0025】なお、図1においては、表示の都合上、誘電体基板11は省略して図示しているが、これらの構造は通常は誘電体基板11中に形成されるものである。また、誘電体導波管線路16の内部の構造が分かるように、主導体層12の一部は破断して示している。

【0026】図1に示すように、所定の厚みCの誘電体基板11を挟持する位置に一对の主導体層12・13が形成されており、主導体層12・13は誘電体基板11の少なくとも伝送線路形成位置を挟む上下面に形成されている。また、主導体層12・13間には主導体層12と13とを電気的に接続するスルーホール導体やビア導体等の貫通導体が多数設けられ、これら多数の貫通導体により2列の側壁用貫通導体群14を形成している。

【0027】2列の側壁用貫通導体群14は、高周波信号の伝送方向すなわち線路形成方向に信号波長の2分の1未満（望ましくは4分の1以下）の所定の繰り返し間隔（ピッチ）Bで、かつ伝送方向と直交する方向に所定の間隔（幅）Aをもって形成されている。これにより、この誘電体導波管線路16における電気的な側壁を形成している。

【0028】ここで、誘電体基板11の厚みすなわち一对の主導体層12・13間の間隔Cに対する制限は特にないが、シングルモードで用いる場合には側壁用貫通導体群14の幅Aに対して2分の1程度または2倍程度とすることがよい。図1の例では誘電体導波管16のH面に当たる部分が主導体層12・13で、E面に当たる部分が側壁用貫通導体群14および副導体層15でそれぞれ形成される。また、側壁用貫通導体群14の幅Bに対して誘電体基板11の厚みを2倍程度とすれば、誘電体導波管線路16のE面に当たる部分が主導体層12・13で、H面に当たる部分が側壁用貫通導体群14および副導体層15でそれぞれ形成されることとなる。

【0029】また、貫通導体の繰り返し間隔Bが信号波長の2分の1未満の間に設定されることで、側壁用貫通導体群14により電気的な壁が形成できる。この間隔Bは、望ましくは信号波長の4分の1以下である。

【0030】平行に配置された一对の主導体層12・13間にはTEM波が伝播できるため、側壁用貫通導体群14の各列における貫通導体の繰り返し間隔Bが信号波長λの2分の1（ $\lambda/2$ ）よりも大きいと、その隙間がスロットとして作用して電磁波が漏れるので、この誘電体導波管線路16に電磁波を給電しても電磁波は側壁用貫通導体群14の間から漏れてしまい、ここで作られる疑似的な導波管線路に沿って伝播しない。しかし、その間隔Bが $\lambda/2$ より小さいと、電気的な側壁を形成することとなって電磁波は誘電体導波管線路16に対して垂直方向に伝播することができず、反射しながら誘電体導波管線路16の信号伝送方向に伝播される。その結果、図1のような構成によれば、一对の主導体層12・13と2列の側壁用貫通

導体群14および副導体層15とによって囲まれる断面積がA×Cのサイズの領域が誘電体導波管線路16となる。

【0031】なお、図1に示した例では側壁用貫通導体群14は2列に形成したが、この側壁用貫通導体群14を4列あるいは6列に配設して、側壁用貫通導体群14による疑似的な導体壁を2重・3重に形成することにより、導体壁からの電磁波の漏れをより効果的に防止することができる。

【0032】このような誘電体導波管線路16によれば、10誘電体導波管による伝送線路となるので、誘電体基板11の比誘電率を $\epsilon_r$ とするとその導波管サイズは通常の導波管の $1/\sqrt{\epsilon_r}$ の大きさになる。従って、誘電体基板11を構成する材料の比誘電率 $\epsilon_r$ を大きいものとするほど導波管サイズを小さくすることができて高周波回路の小型化を図ることができ、高密度に配線が形成される多層配線基板または半導体素子収納用パッケージあるいは車間レーダの伝送線路としても利用可能な大きさの誘電体導波管線路16とができる。

【0033】なお、側壁用貫通導体群14を構成する貫通導体は前述のように信号波長の2分の1未満の繰り返し間隔で配設されており、この繰り返し間隔は良好な伝送特性を実現するためには一定の繰り返し間隔とすることが望ましいが、信号波長の2分の1未満の間隔であれば、適宜変化させたりいくつかの値を組み合わせたりしてもよい。

【0034】このような誘電体導波管線路16を構成する誘電体基板11としては、誘電体として機能し高周波信号の伝送を妨げることのない特性を有するものであればとりわけ限定するものではないが、伝送線路を形成する際の精度および製造の容易性の点からは、誘電体基板11はセラミックスから成ることが望ましい。

【0035】このようなセラミックスとしてはこれまで様々な比誘電率を持つセラミックスが知られているが、本発明に係る誘電体導波管線路によって高周波信号を伝送するためには常誘電体であることが望ましい。これは、一般に強誘電体セラミックスは高周波領域では誘電損失が大きく伝送損失が大きくなるためである。従って、誘電体基板11の比誘電率 $\epsilon_r$ は4～100程度が適当である。

【0036】また、一般に多層配線基板や半導体素子収納用パッケージあるいは車間レーダに形成される配線層の線幅は最大でも1mm程度であることから、比誘電率が100の材料を用い、上部がH面すなわち磁界が上側の面に平行に巻く電磁界分布になるように用いた場合は、用いることのできる最小の周波数は15GHzと算出され、マイクロ波帯の領域でも利用可能となる。

【0037】一方、一般的に誘電体基板11として用いられる樹脂からなる誘電体は、比誘電率 $\epsilon_r$ が2程度であるため、線幅が1mmの場合は約100GHz以上でないと利用することができないものとなる。

【0038】また、このような常誘電体セラミックスの中にはアルミナやシリカ等のように誘電正接が非常に小さなものが多いため、全ての常誘電体セラミックスが利用可能であるわけではない。誘電体導波管線路の場合は導体による損失はほとんどなく、信号伝送時の損失のほとんどは誘電体による損失である。その誘電体による損失  $\alpha$  (dB/m) は次のように表わされる。

$$\alpha = 27.3 \times \tan \delta / [\lambda / \{1 - (\lambda / \lambda_c)^2\}^{1/2}]$$

式中、 $\tan \delta$  : 誘電体の誘電正接

$\lambda$  : 誘電体中の波長

$\lambda_c$  : 遮断波長

規格化された矩形導波管 (WRJシリーズ) 形状に準ずると、上式中の  $\{1 - (\lambda / \lambda_c)^2\}^{1/2}$  は0.75程度である。

【0039】従って、実用に供し得る伝送損失である-100 dB/m以下にするには、次の関係が成立するよう誘電体を選択することが必要である。

$$f \times \epsilon_r^{1/2} \times \tan \delta \leq 0.8$$

式中、 $f$  は使用する高周波信号の周波数 (GHz) である。

【0040】このような誘電体基板11としては、例えばアルミナセラミックスや窒化アルミニウムセラミックス・ガラスセラミックス等がある。これらによる誘電体基板11は、例えばセラミックス原料粉末に適当な有機溶剤・溶媒を添加混合して泥漿状になすとともに、これを從来周知のドクターブレード法やカレンダーロール法等を採用してシート状となすことによって複数枚のセラミックグリーンシートを得て、しかる後、これらセラミックグリーンシートの各々に適当な打ち抜き加工を施すとともにこれらを積層し、アルミナセラミックスの場合は1500~1700°C、ガラスセラミックスの場合は850~1000°C、窒化アルミニウムセラミックスの場合は1600~1900°Cの温度で焼成することによって製作される。

【0041】また、一対の主導体層12・13および副導体層15、ならびに高周波用線路導体20および接続用線路導体18は、例えば誘電体基板11がアルミナセラミックスから成る場合には、タンゲステン等の金属粉末に適当なアルミナ・シリカ・マグネシア等の酸化物や有機溶剤・溶媒等を添加混合してベースト状にしたもの用いて厚膜印刷法により少なくとも伝送線路を完全に覆うようにセラミックグリーンシート上に印刷し、しかる後、約1600°Cの高温で焼成し、厚み5~15 μm程度となるようにして形成する。なお、金属粉末としては、ガラスセラミックスの場合は銅・金・銀が、窒化アルミニウムセラミックスの場合はタンゲステン・モリブデンが好適である。また、主導体層12・13および副導体層15の厚みは一般的に5~50 μm程度とされる。

【0042】また、側壁用貫通導体群14ならびに接続用貫通導体17を構成する貫通導体は、例えばビアホール

導体やスルーホール導体等により形成すればよい。その断面形状は製作が容易な円形の他、矩形や菱形等の多角形であってもよい。これら貫通導体は、例えばセラミックグリーンシートに打ち抜き加工を施して作製した貫通孔に主導体層12・13等と同様の金属ベーストを埋め込み、しかる後、誘電体基板11等と同時に焼成して形成する。なお、貫通導体は直径50~300 μmが適当である。

【0043】

【実施例】次に、本発明の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造の具体例について説明する。

【0044】図2は本発明の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造の実施の形態の一例の概略構成を示す斜視図であり、図1と同様の箇所には同じ符号を付してあり、誘電体基板11は表示を省略してある。また、理解を容易にするために側壁を形成するための側壁用貫通導体群14および副導体層15については等価的な側壁で表現し、誘電体導波管線路16は輪郭で表示している。

【0045】この例の場合は、誘電体基板に比誘電率  $\epsilon_r$  が4.8のセラミックス材料を用い、誘電体導波管線路16の断面のサイズを1.5 mm×0.6 mm、高周波用線路導体20としてのマイクロストリップ線路の線路幅を0.267 mmとした。また、誘電体導波管線路16は厚みが0.15 mmの誘電体基板を4枚積層して構成した。

【0046】この例ではマイクロストリップ線路の上部は空気とされ、その線路導体20の端部誘電体導波管線路16の開口端に0.279 mm挿入されている。変換器19は、0.15mm間隔で接続用線路導体18を2層形成し、各線路導体18の端部同士および高周波用線路導体20の端部ならびに誘電体導波管線路16の主導体層12との間を接続用貫通導体17で電気的に接続した。このとき、1層目および2層目の接続用線路導体18は、いずれも幅0.267 mm・長さ0.279 mmとした。また、接続用貫通導体17は直径0.1 mm・長さ0.15mmとした。これにより、誘電体導波管線路16の開口端に挿入された高周波用線路導体20の端部は、複数の接続用貫通導体17および複数の接続用線路導体18を経て誘電体導波管線路16の主導体層12と電気的に接続されている。

【0047】そして、この例ならびに変換部19(接続用貫通導体17および接続用線路導体18)を設けなかった比較例につき、接続構造の反射係数  $S_{11}$  をネットワーク・アナライザにより測定して求めた。その結果を図3に示す。

【0048】図3は誘電体導波管線路の高周波用線路導体との接続構造における反射係数  $S_{11}$  の周波数特性を示す線図であり、横軸は周波数(単位: GHz)を、縦軸は反射係数  $S_{11}$  (単位: dB)を表わし、反射係数  $S_{11}$  の周波数特性を示す特性曲線のうちAは比較例の特性を、Bは本発明の実施例の特性を示している。

【0049】図3の結果より、変換部が無い比較例の結

果Aにおいては反射係数  $S_{11}$  は-6 dB程度までにしかならなかったのに対し、本発明の接続構造の結果Bによれば、接続用貫通導体および接続用線路導体から成る変換部を設けることにより、反射係数  $S_{11}$  が-20 dB以下の良好な特性が得られたことが分かる。このことは、本発明の接続構造にかかる変換部（接続用貫通導体および接続用線路導体）により、誘電体導波管線路と高周波用線路導体との特性インピーダンスのマッチングが行なわれていることを示すものである。

#### 【0050】

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造によれば、誘電体導波管線路の開口端に高周波用線路導体の端部を挿入し、その端部と誘電体導波管線路の主導体層の一方とを、高周波用線路導体と同じ伝送方向で平行に配設された接続用線路導体と、この接続用線路導体の端部に直交して配設された接続用貫通導体とにより階段状を成すように電気的に接続したことから、接続部の厚みを薄い構造とすることができる小型化を図ることができ、しかも、接続部における高周波信号の反射損失が小さく優れた透過特性を得ることができる。さらに、誘電体導波管線路と高周波用線路導体との特性インピーダンスが異なる場合であっても、特性インピーダンスのマッチングをとって良好な特性で接続させることができる。

【0051】しかも、本発明の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造は、グリーンシート積層法等のシート積層技術により容易に作製することができるの

で、生産性が高く安価に製造することができる。

【0052】以上により、本発明によれば、積層型の誘電体導波管線路と、他のマイクロストリップ線路やストリップ線路・高周波線路等の高周波用線路導体とを、両者の特性インピーダンスが異なるものであっても良好な特性で接続することができる誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造を提供することができた。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造の実施の形態の一例を示す部分破断斜視図である。

【図2】本発明の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造の実施の形態の一例の概略構成を示す斜視図である。

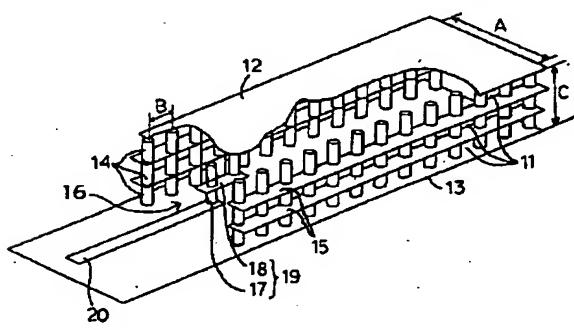
【図3】誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造における反射損失の周波数特性を示す線図である。

【図4】従来の誘電体導波管線路と高周波用線路導体との接続構造の例の概略構成を示す斜視図である。

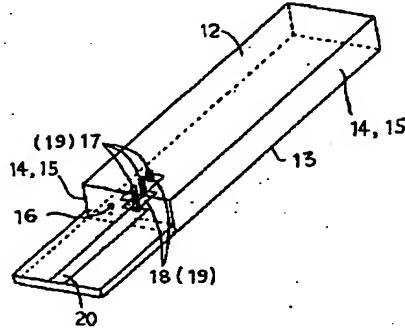
#### 【符号の説明】

20	11 . . . . . 誘電体基板
	12、13 . . . 主導体層
	14 . . . . . 側壁用貫通導体群
	15 . . . . . 副導体層
	16 . . . . . 誘電体導波管線路
	17 . . . . . 接続用貫通導体
	18 . . . . . 接続用線路導体
	20 . . . . . 高周波用線路導体

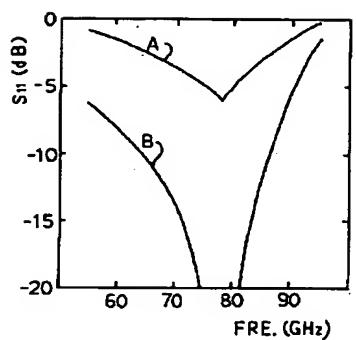
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

